

Το ηλεκτρικό πεδίο

▷ Ένα φορτισμένο σφαιρίδιο Α "προσποιεί" (λόγω των φορτίων του) τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε: ένα φορτισμένο σφαιρίδιο Β (λόγω των φορτίων του) "αισθάνεται", πως έχει προσποιηθεί ο χώρος στη θέση που βρίσκεται  $\Rightarrow$  απόκριση: "αισθάνεται", τη δύναμη Coulomb.

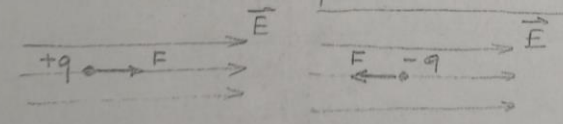
▷ Αν ένα "δοκιμαστικό" φορτίο <sup>προσποιηθεί σε ένα σφαιρίδιο και υποστεί ηλ. δύναμη</sup>  $\Rightarrow$   $\Xi$  ηλ. πεδίο στο σφαιρίδιο αυτό.

▷ Δύναμη: διάνυσμα  $\Rightarrow$  ηλ. πεδίο: διάνυσμα.

▷ Ορισμός ηλ. πεδίου:  $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$   $\rightarrow [E] = \frac{N}{C}$  \*

▷ Αν ξέρουμε το  $\vec{E} \Rightarrow$  βρίσκουμε το  $\vec{F}$

▷ \* Από τον ορισμό:  $\boxed{\text{ηλ. πεδίο} = \text{δύναμη} / \text{θετικό φορτίο}}$



Ηλ. δύναμη: ιδία κατ'έναντι το ηλ. πεδίο  
Ηλ. δύναμη: αντίθετη κατ'έναντι το ηλ. πεδίο

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$  θυμίζει την  $\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m}$   
Βαρυνική δύναμη / μονάδα μάζας

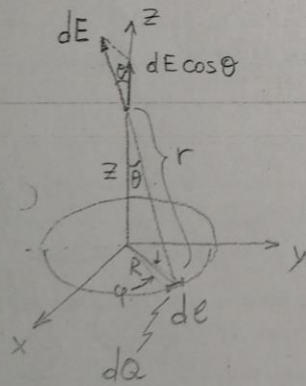
∴ Δύναμη από ηλ. φορτίο  $q$  στο ηλ. φορτίο  $q'$ :

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} \hat{r}$$

⇒ Ηλ. πεδίο που δημιουργείται από  $q$  σε απόσταση  $r$ :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \rightarrow \text{Πεδίο επιφανείως φορτίου}$$

∴ Παράδειγμα [Οθωνίαν, p.23]: Συνολική ροή του φορτίου  $Q$  είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε <sup>σφαίρα</sup> δακτύλιο ακτίνας  $R$ . Ποιο είναι το ηλ. πεδίο στον άξονα του δακτυλίου?



▷ Φορτίο / μονάδα μήκους =  $\frac{Q}{2\pi R}$  = χρ. μήκος

▷ Φορτίο στο τμήμα  $dl$ :  $dQ = \frac{Q}{2\pi R} dl$

▷  $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q dl}{2\pi R} \frac{1}{z^2 + R^2}$

Κατανομή εντάσεων του  $dE$ :

$$\left. \begin{aligned} dE_z &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q dl}{2\pi R} \frac{\cos\theta}{z^2 + R^2} \\ dl &= R d\phi; \cos\theta = \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{2\pi R} \frac{z}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} R d\phi$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qz}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\left[ \begin{aligned} \frac{2\pi R}{dl} &\overset{Q}{=} \frac{dQ}{dl} \\ \Rightarrow dQ &= \frac{Q}{2\pi R} dl \end{aligned} \right]$$

Διανυσματικά:  $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qz}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \hat{z}$

▷ Στο όριο  $z=0 \Rightarrow \vec{E}=0$

▷ Στο όριο  $z \gg R \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{z^2} \hat{z}$

ηλ. ραδιο αμειωτικού φορτίου

Go to p. 8a

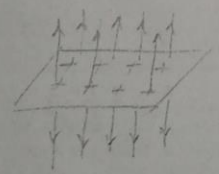
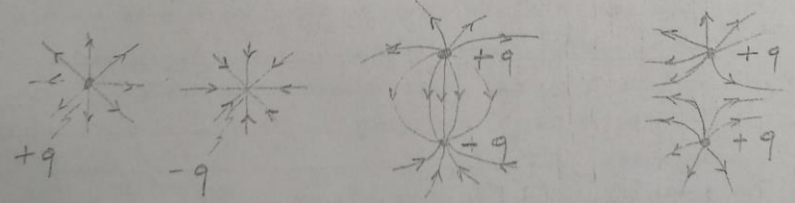
Γραφές ηλ. ραδίου (δυναμικές γραφές)

▷ Το ηλ. ραδιο αναπαρίσταται ως διάνυσμα →

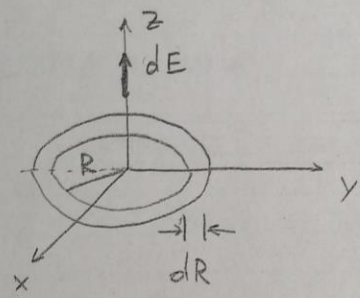
Δυναμική γραφή: σε οποιοδήποτε σημείο της, η εφαπτομένη στη γραφή δείχνει τη δυν. του ηλ. ραδίου

Επίσης: η πυκνότητα των γραμμών ~ μέτρο του ραδίου

- ▷ Οι δυν. γραφές ξεκινούν από θετικό φορτίο και καταλήγουν σε αρνητικό, ή συνεχίζονται ως  $z \rightarrow \infty$ .
- [όπως η δύναμη που θα ασκούνταν σε θετικό φορτισμένο σωματίδιο].



Ηλ. ραδιο επίπεδου φύλλου που φέρει  
ομοιόμορφο φορτίο πυκνότητας  $\rho$  [C/m<sup>2</sup>].



- ▷ Το φύλλο θεωρείται ότι έχει διαστάσεις άπειρου μήκους
- ▷ Το φύλλο αποτελείται από ένα μεγάλο πλήθος διαδοχικών ομόκεντρων δακτυλίων.
- ▷ Θεωρούμε ένα τέτοιο δακτύλιο ακτίνας R και πλάτους dR.

Ο δακτύλιος έχει εμβαδόν =  $2\pi R dR$   
 — u — φορτίο :  $dQ = (2\pi R dr) \cdot \rho$

Άρα το παρακάτω ηλ. ραδιο που δημιουργεί είναι:

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi R \rho z dR}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E = \frac{2\pi\rho z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \frac{R dR}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

→ (R = ∞ ο μεγαλύτερος δακτύλιος)

→ (R = 0 ο μικρότερος δακτύλιος)

Για το οδοκλήρωμα:

$$R^2 = u, \text{ οπότε } \downarrow$$

$$2R dR = \frac{1}{2} du$$

$$\int_0^\infty \frac{R dR}{(z^2 + R^2)^{3/2}} = \int_0^\infty \frac{\frac{1}{2} du}{(z^2 + u^2)^{3/2}}$$

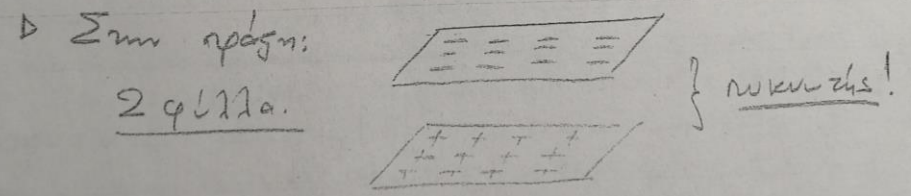
$$= \frac{-1}{(z^2 + u^2)^{1/2}} \Big|_0^\infty = \frac{1}{z}$$

Άρα  $E = \frac{2\pi\rho z}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{z} \Rightarrow E = \frac{\rho}{2\epsilon_0}$

και σε διανυσματική μορφή:  $\vec{E} = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \hat{z}$

Συνοψίζω: Το πλ. πεδίο  $\sim \rho$  (πυκνότητας φορτίου)  
 και είναι σταθερό  $\Rightarrow$  ανεξάρτητο από την απόσταση  
 από το φύλλο!

$\gg$  Ισχύει προσεγγιστικά όχι μόνο για άπειρο φύλλο  
 αλλά και για φύλλο πεπερασμένου διαστάσεων  
 { σε απόσταση  $\ll$  από τις πλευρές  
 και μακριά από τα άκρα }

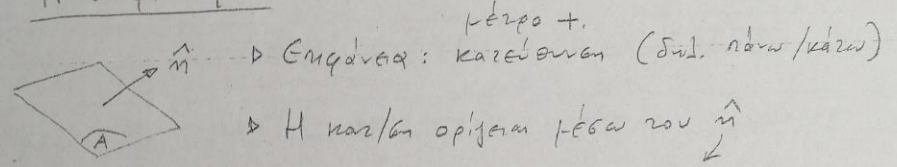


$\triangleright$  Πεδίο μεταξύ των φύλλων (το ένα +, το άλλο -)

$$E = \frac{\rho}{2\epsilon_0} + \frac{\rho}{2\epsilon_0} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$\triangleright$  Πεδίο "εξωτερικά" των φύλλων = 0.

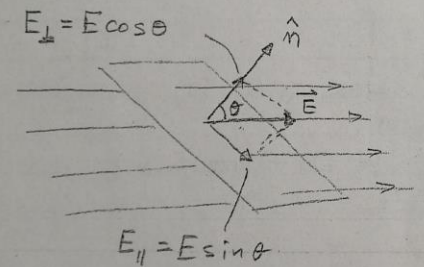
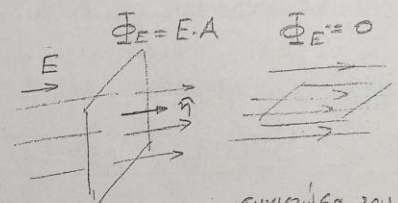
Ηλεκτρική ροή:



Τανυστικό διάνυσμα  $\perp$  επιφάνεια  
 $|\hat{n}| = 1$ .

$\therefore$  Άρα:  $\vec{A} = A \cdot \hat{n}$

Ηλεκτρική ροή:  $\Phi_E = \begin{cases} E \cdot A, & \hat{n} \parallel \vec{E} \\ 0, & \hat{n} \perp \vec{E} \end{cases}$



Γενικά:  
 $\Phi_E = E \cdot A \cdot \cos \theta$ , δωλ.  
 συνιστώσα του E που είναι  $\parallel \hat{n}$  δωλ.  $\perp$  επιφάνεια  
 $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$

και για στοιχειώδη επιφάνεια

$\Phi_E = \int E \cos \theta dA = \int E_{\perp} dA = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$

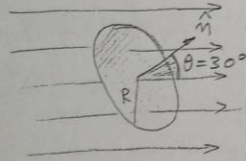
\* { Ηλ. ροή σε μια επιφάνεια = αριθμός των γραμμών του πεδίου που διέρχονται από την επιφάνεια } \*

\* { Το πλ. πεδίο = αριθμός δωλ. γραμμών / μονάδα επιφάνειας } \*

Παραδείγματα

① Ηλ. ροή διαρέου ενός δίσκου (ανοικτή επιφάνεια)

Δίσκος ακτίνας 0.1m; πεδίο  $E = 2 \times 10^3 \frac{N}{C}$ ; Ροή = ?

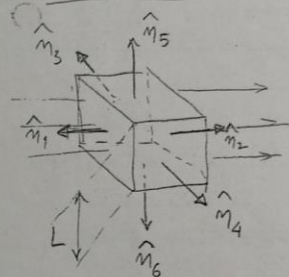


$$\Phi_E = E \cdot A \cos \theta$$

$$A = \pi R^2 = \pi (0.1m)^2 = 0.0314 m^2$$

$$\Rightarrow \Phi_E = 2 \times 10^3 \frac{N}{C} \times 0.0314 m^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 54 \frac{N \cdot m^2}{C}$$

② Ηλ. ροή διαρέου ενός κύβου (κλειστή επιφάνεια χωρίς ηλ. φορτίο)



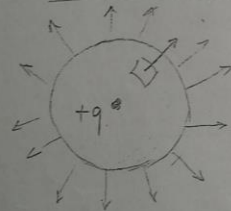
$$\Phi_E = \Phi_{E1} + \Phi_{E2} + \Phi_{E3} + \Phi_{E4} + \Phi_{E5} + \Phi_{E6}$$

$$\frac{-EL^2}{\cos \theta = \cos 180^\circ = -1} + \frac{+EL^2}{\cos \theta = \cos 0^\circ = +1} + \underbrace{0}_{\text{γιατί } \hat{n} \perp \vec{E}} + \underbrace{0}_{\text{γιατί } \hat{n} \perp \vec{E}} + \underbrace{0}_{\text{γιατί } \hat{n} \perp \vec{E}} + \underbrace{0}_{\text{γιατί } \hat{n} \perp \vec{E}}$$

$$\Rightarrow \vec{E} \cdot \vec{A} = EL^2 \cos 90^\circ = 0$$

[Για κάθε έδρα:  $\vec{A} = L^2 \hat{n}$ ] Άρα:  $\Phi_E = 0$

③ Ηλ. ροή διαρέου σφαίρας στο κέντρο της οποίας υπάρχει +q. (κλειστή επιφάνεια με ηλ. φορτίο)



Ηλ. πεδίο του επιφανειακού φορτίου:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \perp \text{ στην σφαίρα και έχει την ίδια τιμή παντού πάνω στην σφαίρα.}$$

Άρα:  $\Phi_E = \int E dA = E \int dA = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} 4\pi R^2 \Rightarrow \Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$